

а 2002 0071

Изобретение относится к электронике, в частности к технологии полупроводников.

Способ получения полисульфидных пленок включает нанесение сульфидных соединений на подложку и последующую термообработку. Новизна заключается в том, что подложку предварительно обрабатывают раствором  $ZnCl_2$ , высушивают при температуре 373 К, сульфидное соединение  $Zn_xIn_2S_{3+x}$  ( $x=1, 2, 3, 5$ ) смешивают с раствором  $ZnCl_2$ , а термообработку проводят при условии  $T \cdot t = (6,3 - 8,5)10^3$  град·час, где

T - температура обработки;

t - время обработки.

П. формулы: 1